

Mẫu số 01

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ
PHẠM KỸ THUẬT TPHCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN
CHỨC DANH: PHÓ GIÁO SƯ

Mã hồ sơ:



Đối tượng đăng ký: Giảng viên ; Giảng viên thỉnh giảng
Ngành: Điện-Điện tử; Chuyên ngành: Điện tử-Viễn thông

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN

- Họ và tên người đăng ký: **VÕ MINH HUÂN**
- Ngày tháng năm sinh: 04/09/1982; Nam ; Nữ ; Quốc tịch: Việt Nam;
Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không
- Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam:
- Quê quán: xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố: Thị Trấn Hòa Hiệp Trung, Huyện Đông Hòa, Tỉnh Phú Yên.
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (số nhà, phố, phường, quận, thành phố hoặc xã, huyện, tỉnh):
Số 72, Đường D16, Tổ 8, Khu Phố 6, Phước Long B, Quận 9, TPHCM.
- Địa chỉ liên hệ (ghi rõ, đầy đủ để liên hệ được qua Bưu điện): Khoa Điện-Điện Tử, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM, Số 01 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, TPHCM.
Điện thoại di động: 0909437522; E-mail: huanvm@hcmute.edu.vn.
- Quá trình công tác (công việc, chức vụ, cơ quan):
Từ năm 06/2005 đến 04/2008: Kỹ sư thiết kế phần cứng vi mạch, Công Ty Signet Design Solutions, Việt Nam.
Từ năm 04/2008 đến năm 08/2009: Giảng Viên, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM.
Từ năm 08/2009 đến năm 08/2013: Nghiên cứu sinh, Trường Đại Học Kookmin, Hàn Quốc.
Từ 08/2013 đến năm 11/2013: Giảng viên, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM
Từ năm 11/2013 đến năm 07/2014: Giảng viên, Trưởng Bộ môn Điện Tử-Viễn Thông, Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM.
Từ 10/2014 đến năm 11/2014: Học giả nghiên cứu tại Khoa Điện-Điện Tử-Máy tính, Đại học Queen's Belfast, Vương Quốc Anh.
Từ 07/2014 đến nay: Giảng Viên, Phó Trưởng Khoa Điện-Điện Tử, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM.



Chức vụ: Hiện nay: Phó Trưởng Khoa, Khoa Điện-Điện Tử, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM.; Chức vụ cao nhất đã qua: Phó Trưởng Khoa.

Cơ quan công tác hiện nay: Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM.

Địa chỉ cơ quan: Số 01, Võ Văn Ngân, Linh Chiểu, Thủ Đức, TPHCM

Điện thoại cơ quan (+84 - 028) 38968641 - (+84 -028) 38961333 - (+84 -028) 37221223

Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học (nếu có):

8. Đã nghỉ hưu từ thángnăm

Nơi làm việc sau khi nghỉ hưu (nếu có):

Tên cơ sở giáo dục đại học nơi hợp đồng thỉnh giảng 3 năm cuối (tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ):

9. Học vị:

- Được cấp bằng ĐH ngày 22 tháng 03 năm 2005, ngành: Điện-Điện Tử, chuyên ngành: Điện Tử-Viễn Thông.

Nơi cấp bằng ĐH (trường, nước): Trường Đại Học Bách Khoa TPHCM, Việt Nam.

- Được cấp bằng ThS ngày 29 tháng 10 năm 2007, ngành: Kỹ Thuật, chuyên ngành: Điện-Điện Tử.

Nơi cấp bằng ThS (trường, nước): Trường Đại Học Bách Khoa TPHCM, Việt Nam.

- Được cấp bằng TS ngày 21 tháng 08 năm 2013, ngành: Kỹ Thuật Điện Tử, chuyên ngành: Kỹ Thuật Điện Tử.

Nơi cấp bằng TS (trường, nước): Trường Đại Học Kookmin, Hàn Quốc.

-Học giả nghiên cứu sau Tiến sỹ (2 tháng) tại Khoa Điện-Điện Tử-Máy tính, Đại học Queen's Belfast, Vương Quốc Anh.

10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS ngày tháng năm

ngành:

11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo Sư tại HDGS cơ sở: Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM.

12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo Sư tại HDGS ngành, liên ngành: Điện-Điện Tử-Tự Động Hóa.

13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu:

-Thiết kế vi mạch công suất thấp

-Thiết kế vi mạch dùng linh kiện điện trở nhớ memristor

-Thiết kế hệ thống kết nối vạn vật (Internet of Things) thông minh

14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học:

- Đã hướng dẫn (số lượng) 10 HVCH bảo vệ thành công luận văn;

- Đã hoàn thành (số lượng) 04 đề tài NCKH cấp trường trọng điểm và thành viên đề tài cấp Quốc gia;

- Đã công bố (số lượng) 43 bài báo KH, trong đó 15 bài báo KH trên tạp chí quốc tế có uy tín;

TRU
HOC
Y
HO

- Số lượng sách đã xuất bản 03 trong đó 03 thuộc nhà xuất bản có uy tín;

Liệt kê không quá 5 công trình KH tiêu biểu nhất

[1]. Minh-Huan Vo, “A diagonally weighted binary memristor crossbar architecture based on multilayer neural network for better accuracy rate in speech recognition application”, *Advances in Electrical and Computer Engineering*, Vol. 19, No. 2, pp. 75-82, May 2019, ISSN: 1582-7445, (SCIE, IF=0.65).

[2]. Minh-Huan Vo, “Multilayer Neural Network with Synapse Based on Two Successive Memristors”, *The open electrical and Electronics Journal*, No. 12, pp. 132-157, Dec 2018, ISSN: 1874-1290 (Scopus, H-index=6).

[3]. Huan Minh Vo and Quoc Ai Dao, “Dual Recycled Charge Power Gating For Retaining Data and Saving Leakage”, *Indian Journal of Science and Technology*, pp. 1-6, Vol 11 No. 6, February 2018, ISSN: 0974-6846. (ISI, IF=5.07).

[4]. Minh-Huan Vo, “Implementing Energy Saving Techniques for Sensor Nodes in IoT Applications”, *EAI Endorsed Transactions on Industrial Networks and Intelligent Systems*, Volume 5, Issue 17, pp. 1-7, 19 December 2018, ISSN: 2410-0218.

[5]. Huan Minh Vo, “Self-Power Saving Technique in State Machine Circuits for Automatic Teller Machine Application” *Journal of Low Power Electronics* , Vol. 15, N° 3, September 2019. , ISSN: 1546-1998 (SCOPUS & ESCI).

B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ/PHÓ GIÁO SƯ

1. Tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo (tự đánh giá).

a/ Về tiêu chuẩn: Bản thân tự đánh giá ứng cử viên có đủ tiêu chuẩn của nhà giáo theo quy định của Luật Giáo dục và đủ các tiêu chuẩn chung trong Điều 4 của chức danh Giáo sư và Phó Giáo sư và trong Điều 6 về tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư.

Sau khi lấy bằng Tiến sĩ ứng viên được mời là học giả nghiên cứu tại Khoa Điện-Điện Tử-Máy tính, Trường Đại học Queen’s Belfast, Vương Quốc Anh, kinh phí hỗ trợ của Hội Đồng Anh. Tác giả tham gia tổ chức hội thảo khoa học thường niên giữa Hàn Quốc và Việt Nam từ 2014 (Korea-Viet Nam Joint Workshop of Solid-State Circuits and Systems). Ứng cử viên được mời tham gia phản biện tạp chí uy tín (*Etri Journal*), hội nghị quốc tế, phản biện các đề tài cấp Đại học Quốc Gia, cấp Bộ, cấp Nhà nước. Ứng cử viên được đào tạo phương pháp giảng dạy tích cực của HEEAP tại Trường Đại học Arizona, Mỹ. Ứng cử viên xây dựng và kiểm định các chương trình đào tạo đại học theo chuẩn AUN-QA.

b/ Về nhiệm vụ: Bản thân ứng cử viên tự đánh giá là luôn hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ của một nhà giáo.

V
ING
TU P
AU
CHIM
★

2. Thời gian tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên:

Tổng số 07 năm.

TT	Năm học	Hướng dẫn NCS		HD luận văn ThS	HD đồ án, khóa luận tốt nghiệp ĐH	Giảng dạy		Tổng số giờ giảng/số giờ quy đổi
		Chính	Phụ			ĐH	SĐH	
1	8/2013-7/2014				473	477		950
2	8/2014-7/2015			140	325	443	45	953
3	8/2015-7/2016			140	275	223	135	773
3 năm học cuối								
4	8/2016-7/2017			140	165	268	90	663
5	8/2017-7/2018			70	130	235	45	480
6	8/2018-7/2019			140	160	267		567

3. Ngoại ngữ:

3.1. Ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: Tiếng Anh

a) Được đào tạo ở nước ngoài :

- Học ĐH ; Tại nước:; Từ năm đến năm

- Bảo vệ luận văn ThS hoặc luận án TS hoặc TSKH ; Tại nước: Hàn Quốc năm 2013.

b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước :

- Trường ĐH cấp bằng tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ: số bằng:; năm cấp:

c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài :

- Giảng dạy bằng ngoại ngữ: Tiếng Anh

- Nơi giảng dạy (cơ sở đào tạo, nước): Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM, Việt Nam

d) Đối tượng khác ; Diễn giải:

3.2. Tiếng Anh (văn bằng, chứng chỉ):

4. Hướng dẫn thành công NCS làm luận án TS và học viên làm luận văn ThS (đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng)

TT	Họ tên NCS hoặc HV	Đối tượng		Trách nhiệm HD		Thời gian hướng dẫn từ đến ...	Cơ sở đào tạo	Năm được cấp bằng/có quyết định cấp bằng
		NCS	HV	Chính	Phụ			
1	Nguyễn Quang On		X	X		28/2/2018-28/8/2018	ĐHSPKT TPHCM	28/12/2018
2	Phạm Sanh		X	X		27/2/2017-27/8/2017	ĐHSPKT TPHCM	30/12/2017
3	Hà Văn Quân		X	X		29/08/2016-28/02/2017	ĐHSPKT TPHCM	30/6/2017
4	Lê Ngọc Thanh		X	X		22/02/2016-22/8/2016	ĐHSPKT TPHCM	30/12/2016
5	Huỳnh Hoàng Hà		X	X		01/9/2014-28/2/2015	ĐHSPKT TPHCM	30/6/2015

5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo đại học và sau đại học

(Tách thành 2 giai đoạn: Đối với ứng viên chức danh PGS: Trước khi bảo vệ học vị TS và sau khi bảo vệ học vị TS; đối với ứng viên GS: Trước khi được công nhận chức danh PGS và sau khi được công nhận chức danh PGS)

Sau khi bảo vệ TS

TT	Tên sách	Loại sách (CK, GT, TK, HD)	Nhà xuất bản và năm xuất bản	Số tác giả	Viết MM hoặc CB, phần biên soạn	Xác nhận của CS GDDH (Số văn bản xác nhận sử dụng sách)
1	Giáo Trình Thiết Kế Mạch Tích Hợp CMOS	GT	NXB Đại học QG Tp. HCM, 2019	01	MM	Quyết định xuất bản số: 58/QĐ-ĐHQGTPHCM ngày 13/5/2019.
2	Giáo Trình Thực Hành Phân Tích và Mô Phỏng Mạch Điện	TLTK	NXB Đại Học QG Tp. HCM, 2017	02	CB	Quyết định xuất bản số: 135/QĐ-ĐHQGTPHCM ngày 18/7/2017.
3	Lập Trình Điều Khiển với Raspberry	TLTK	NXB Thanh Niên, 2017	02	CB	Quyết định xuất bản số: 492/QĐ-TN ngày 11/7/2017

- Trong đó, sách chuyên khảo xuất bản ở NXB uy tín trên thế giới sau khi được công nhận PGS (đối với ứng viên chức danh GS) hoặc cấp bằng TS (đối với ứng viên chức danh PGS):

Các chữ viết tắt: CK: sách chuyên khảo; GT: sách giáo trình; TK: sách tham khảo; HD: sách hướng dẫn; MM: viết một mình; CB: chủ biên; phần ứng viên biên soạn đánh dấu từ trang.... đến trang..... (ví dụ: 17-56; 145-329).

6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu

TT	Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ (CT, ĐT...)	CN/PCN/TK	Mã số và cấp quản lý	Thời gian thực hiện	Thời gian nghiệm thu (ngày, tháng, năm)
1	Kỹ thuật thiết kế mạch giảm công suất rò trong vi mạch số	CN	Trường trọng điểm. Mã số T2015-28TĐ	1/2015-12/2015	25/3/2016
2	Ứng dụng Memristor trong thiết kế số công suất thấp	CN	Trường trọng điểm. Mã số T2016-45TĐ	1/2016-12/2016	1/12/2016
3	Vi mạch công suất thấp trong chế độ lưu trữ dữ liệu dùng công nghệ submicrometter	CN	Trường trọng điểm. Mã số T2017-76TĐ	1/2017-12/2017	13/4/2018
4	Thiết kế mạch kết hợp lại giữa CMOS và Memristor để xây dựng kiến trúc mạng neuron	CN	Trường trọng điểm. Mã số T2018-45TĐ	1/2018-12/2018	04/1/2019
5	Nghiên cứu các lỗi phân cứng mã hóa nhận thực công suất siêu thấp, tốc độ cao cho các mạng không dây tiên tiến	Thành viên	Quốc gia. Mã số: 102.02-2015.20	2015-2017	28/12/2017

Các chữ viết tắt: CT: Chương trình; ĐT: Đề tài; CN: Chủ nhiệm; PCN: Phó chủ nhiệm; TK: Thư ký.

7. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã công bố (bài báo khoa học, sáng chế/giải pháp hữu ích, giải thưởng quốc gia/quốc tế)

7.1. Bài báo khoa học đã công bố

(Tách thành 2 giai đoạn: Đối với ứng viên chức danh PGS: Trước khi bảo vệ học vị TS và sau khi bảo vệ học vị TS; đối với ứng viên GS: Trước khi được công nhận chức danh PGS và sau khi được công nhận chức danh PGS)

Sau khi cấp bằng TS

TT	Tên bài báo	Số tác giả	Tên tạp chí hoặc kỹ yếu khoa học	Tạp chí quốc tế uy tín (và IF)	Số trích dẫn của bài báo	Tập/số	Trang	Năm công bố
1	Self-Power Saving Technique in State Machine Circuits for Automatic Teller Machine Application	01	Journal of Low Power Electronics	ISSN: 1546-1998 H-index=16 (Scopus & ESCI)		15(3)		92019
2	A diagonally weighted binary memristor crossbar architecture based on multilayer neural network for better accuracy rate in speech recognition application	01	Advances in Electrical and Computer Engineering	ISSN: 1582-7445, IF=0.65 (SCIE)		19(2)	75-82	5/2019
3	Multilayer neural network with synapse based on two successive memristors	01	The Open Electrical and Electronics Journal	ISSN: 1874-1290 H-index=6 (Scopus)		12	132-157	12/2018
4	Dual recycled charge power gating for retaining data and saving leakage	02	Indian Journal of Science and Technology	ISSN: 0974-5645 IF=5.07 (ISI)		11(6)	1-6	2/2018
5	Implementing energy saving techniques for sensor nodes in IoT applications	01	EAI Endorsed Transactions on Industrial Networks and Intelligent Systems	ISSN: 2410-0218		5(17)	1-7	12/2018
6	Server-Client control model based on noncontinuous scheduling for power saving in IoT	01	Tạp chí Kỹ Thuật điều khiển và Tự Động Hóa	ISSN: 1859-0551		21(2)	3-10	8/2018
7	Self-power gating technique for low power asynchronous circuit	02	Journal of Institute of Korean Electrical and Electronics Engineering	ISSN : 1226-7244 (KCI&KSCI)		22(3)	548-557,	9/2018

8	Flexible color controller in visible light communication	01	American Journal of Engineering Research	ISSN: 2320-0847	7(9)	278-283	2018
9	Regulated power gating technique for PVT variation-tolerant SRAM in data retention mode	01	International Journal of Science and Research	ISSN 2319-7064 IF=7.3	7(9)	1066-1070	9/2018
10	Comparative study on power gating techniques for lower power delay product, smaller power loss, faster wakeup time	01	EAI Transactions on Industrial Networks and Intelligent Systems	ISSN: 2410-0218	5(15)	1-6	8/2018
11	Tối ưu công suất nạp pin dùng kỹ thuật MPPT điện áp mạch hở phân đoạn cho mảng pin mặt trời	01	Tạp chí khoa học công nghệ thông tin và truyền thông	ISSN 2525-2224	3	33-38	9/2018
12	So sánh mô hình memristor và ứng dụng mô hình điện áp thích nghi để thiết kế công logic	01	Tạp chí khoa học công nghệ thông tin và truyền thông	ISSN 2525-2224	4	49-54	01/2019
13	Low power CAM memory design using power gating technique	02	Journal of Technical Education Science	ISBN- 1859-1272	49	27-31	9/2018
14	Kỹ thuật clock gating tinh chỉnh giảm công suất động tiêu thụ ứng dụng trong trò chơi Ping Pong	01	Tạp chí Khoa Học Kỹ Thuật-Học Viện Kỹ Thuật Quân Sự	ISSN: 1859-0209	11	64-75	4/2018
15	Building reliable protocol based on response packet in prepaid electricity system using power line communication	02	Tạp Chí Khoa Học & Công Nghệ - Đại Học Công Nghiệp Hà Nội	ISSN: 1859-3585	44	26-30	02/2018
16	Flexible frame structure to reduce energy consumption in wireless sensor network for monitoring agriculture	01	Tạp chí Khoa Học và Công Nghệ Đại Học Đà Nẵng	ISSN: 1859-1531	11 (120)	40-46	11/2017
17	Energy management system with low power loss and reliable data transmission based on power line communication	01	Tạp chí Khoa Học Kỹ Thuật-Học Viện Kỹ Thuật Quân Sự	ISSN: 1859-0209.	10	86-100	9/2017
18	Experimental demonstration of	07	Electronic Materials Letters	ISSN:	1	13(1) 86-90	1/2017

	sequence recognition of serial memristors			1738-8090 IF=1.881 (SCI)				
19	Synaptic memristor bridge circuit with pulse width based programmable weights in digit character recognition	02	International Journal of Engineering and Science Invention (IJESI)	ISSN (online) 2319-6734		5(5)	11-17	5/2016
20	Memristor-based character recognition using signal multiplier	02	Journal of Technical Education Science	ISBN- 1859-1272		32	60-66	3/2015
21	CMOS-memristor hybrid 4-bit multiplier for energy efficient computing	04	Journal of Institute of Korean Electrical and Electronics Engineering	ISSN : 1226-7244 (KCI&KSCI)		8(2)	228-233	6/2014
22	Implementing the Markov decision process for efficient water utilization with arduino board in agriculture	02	2019 IEEE International Conference on System Science and Engineering (ICSSE)	ISSN: 2325-0925				7/2019
23	Auto-adjusted pulse width circuit to improve memristor variations in reconfigurable high-pass filter	02	2019 3rd International Conference on Recent Advances in Signal Processing, Telecommunications & Computing (SigTelCom)	ISBN: 978-1-5386-7963-0			38-42	3/2019
24	Advanced AES algorithm using dynamic key in the internet of things system	02	2019 IEEE International Conference on Computer and Communication Systems	ISBN: 978-1-7281-1321-0			682-686	2/2019
25	The merged clock gating architecture for low power digital clock application on FPGA	01	2018 IEEE International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC)	ISBN: 978-1-5386-6542-8			282-286	10/2018

26	45 nm-CMOS temperature sensor using 2 stage Vernier technique	01	The 4th International Conference on Green Technology and Sustainable Development (IEEE)	ISBN: 978-1-5386-5126-1			693-695	11/2018
27	A lossless data compression algorithm to save energy in the wireless sensor network”,	02	The 4th International Conference on Green Technology and Sustainable Development (IEEE)	ISBN: 978-1-5386-5126-1			597-600	2018
28	Training on-chip hardware with two series memristor based backpropagation algorithm	01	International Conference on Communications and Electronics (IEEE ICCE)	ISBN: 978-1-5386-3679-4			179 – 183	7/2018
29	A double regulated footer and header voltage technique for ultra-low power IoT SRAM	01	IEEE 4th World Forum on Internet of Things	ISBN: 978-1-5090-4130-5			107-111	2/2018
30	Online working condition monitoring system integrated power saving and security using zigbee wireless sensor network	01	The 2017 International Conference On Advanced Technologies for Communications	ISSN: 2162-1039	1		140-143	10/2017
31	Implementing the on-chip backpropagation learning algorithm on FPGA architecture	01	2017 International Conference OnSystem Science and Engineering (ICSSE)	ISSN: 2325-0925			538-541	7/2017
32	Optimizing power consumption using multi-bit flip-flop technique in tetris game on FPGA	01	2017 International Conference OnSystem Science and Engineering (ICSSE), July 2017	ISSN: 2325-0925			530-533	7/2017
33	Dynamic CMOS-rectifying memristor multiplier architecture for power reduction	01	IEEE Conference International Conference on IC Design and Technology (ICICDT)	ISBN 978-1-5090-0827-8			1-4	6/2016

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ ĐIỆN TỬ

34	File transfer system with computer using visible light communication technology on FPGA	01	2016 IEEE International Conference on System Science and Engineering (ICSSE)	ISSN: 2325-0925	2	1-3	7/2016
35	Dual-switch power gating technique with small energy loss, short crossover time, and fast wake-up time for fine-grain leakage controlled VLSIs	02	The 2015 International Conference on Advanced Technologies for Communications	ISSN: 2162-1020		264-269	10/2015
36	Dual Recycled Charge for Saving Leakage Power in Carry Look-Ahead Adder for Low Power Applications	02	The 6th International Conference on Integrated Circuits, Design and Verification, IEICE	ISBN: 978-488552-300-7		160-165	8/2015
37	A novel charge recycling technique for saving leakage power in low V _{th} CMOS circuits	02	International Conference on Green Technology and Sustainable Development	ISBN: 978-1-5386-5124-7		482-485	10/2014

Trước khi cấp bằng TS

TT	Tên bài báo	Số tác giả	Tên tạp chí hoặc kỹ yếu khoa học	Tạp chí quốc tế uy tín (và IF)	Số trích dẫn của bài báo	Tập/số	Trang	Năm công bố
1	Zero-sleep-leakage flip-flop circuit with conditional-storing memristor retention latch	05	IEEE Trans. Nanotechnology	ISSN: 1536-125X, IF=2.292 (SCI)	35	11(2)	360-366	3/2012
2	Carry select adder with sub-block power gating for reducing active-mode leakage in sub-32-nm VLSIs	04	IEICE Electronics Express	ISSN: 1349-2543 IF=0.475	1	8(16)	1322-1329	8/2011
3	Compact and efficient	04	IEICE Electronics	ISSN:	2	8(12)	930-	6/201

	maximum power point tracking circuit for portable solar battery charger		Express	1349-2543 IF=0.475 (SCIE)			937	1
4	Dual-switch power gating revisited for small sleep energy loss and fast wake-up time in sub-45-nm nodes	04	IEICE Electronics Express	ISSN: 1349-2543 IF=0.475 (SCIE)	5	8(4)	232-238	2/2011
5	“Memristor-CMOS hybrid integrated circuits for memory, digital, and neuromorphic applications	06	Solid-State Systems Symposium (4S-Symposium)				243-248	8/2012
6	Solutions to minimize the power consumption in nanometer designs	02	The 2007 International Symposium on Electrical & Electronics Engineering (ISEE)	ISBN: 978-604-73-5317-0			64-72	10/2007

- Trong đó, bài báo đăng trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín sau khi được cấp bằng TS:

TT	Tên bài báo	Số tác giả	Tên tạp chí hoặc kỷ yếu khoa học	Tạp chí quốc tế uy tín (và IF)	Số trích dẫn của bài báo	Tập/số	Trang	Năm công bố
1	Self-Power Saving Technique in State Machine Circuits for Automatic Teller Machine Application	1	Journal of Low Power Electronics	ISSN: 1546-1998 (Scopus & ESCI)		15(3)		92019
2	A diagonally weighted binary memristor crossbar architecture based on multilayer neural network for better accuracy rate in speech recognition application	01	Advances in Electrical and Computer Engineering	ISSN: 1582-7445, IF=0.65 (SCIE)		19(2)	75-82	5/2019
3	Multilayer neural network with synapse based on two successive memristors	01	The Open Electrical and Electronics Journal	ISSN: 1874-1290 H-index=6		12	132-157	12/2018

				(Scopus)				
4	Dual recycled charge power gating for retaining data and saving leakage	02	Indian Journal of Science and Technology	ISSN: 0974-5645 IF=5.07 (ISI)	11(6)	1-6	2/2018	
5	Implementing energy saving techniques for sensor nodes in IoT applications	01	EAI Endorsed Transactions on Industrial Networks and Intelligent Systems	ISSN: 2410-0218	5(17)	1-7	12/2018	
6	Self-power gating technique for low power asynchronous circuit	02	Journal of Institute of Korean Electrical and Electronics Engineering	ISSN: 1226-7244 (KCI&KSCI)	22(3)	548-557	9/2018	
7	Flexible color controller in visible light communication	01	American Journal of Engineering Research	ISSN: 2320-0847	7(9)	278-283	2018	
8	Regulated power gating technique for PVT variation-tolerant SRAM in data retention mode	01	International Journal of Science and Research	ISSN 2319-7064 IF=7.3	7(9)	1066-1070	9/2018	
9	Comparative study on power gating techniques for lower power delay product, smaller power loss, faster wakeup time	01	EAI Transactions on Industrial Networks and Intelligent Systems	ISSN: 2410-0218	5(15)	1-6	8/2018	
10	Experimental demonstration of sequence recognition of serial memristors	07	Electronic Materials Letters	ISSN: 1738-8090 (SCI) IF=1.881	13(1)	86-90	1/2017	
11	CMOS-memristor hybrid 4-bit multiplier for energy efficient computing	04	Journal of Institute of Korean Electrical and Electronics Engineering	ISSN: 1226-7244 (KCI&KSCI)	8(2)	228-233	6/2014	

8. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo hoặc chương trình nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của cơ sở giáo dục đại học

9. Các tiêu chuẩn còn thiếu so với quy định cần được thay thế bằng bài báo KH quốc tế uy



tín:

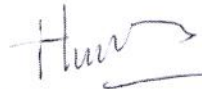
- Thời gian được cấp bằng TS, được bổ nhiệm PGS:
- Giờ chuẩn giảng dạy:
- Công trình khoa học đã công bố:
- Chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ
- Hướng dẫn NCS,ThS:

C. CAM ĐOAN CỦA NGƯỜI DĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH:

Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

TPHCM, ngày 04 tháng 07 năm 2019

Người đăng ký
(Ký và ghi rõ họ tên)



Võ Minh Huân

D. XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU NƠI ĐANG LÀM VIỆC

- Về những nội dung “Thông tin cá nhân” ứng viên đã kê khai.
 - Về giai đoạn ứng viên công tác tại đơn vị và mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn này.
- (Những nội dung khác đã kê khai, ứng viên tự chịu trách nhiệm trước pháp luật).

TPHCM, ngày 05 tháng 07 năm 2019



Ghi chú:

- (1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).
- (2) Tên cơ sở đào tạo.
- (3) Địa danh.